

**ПРОГРАММА**  
**Школы молодых ученых «Физика и технология квантовых систем»**  
**ФТКС-2025, 12–13 ноября 2025 г.**

ИФП СО РАН, г. Новосибирск, пр. Ак. Лаврентьева 13, конференц-зал (3 этаж)



**Среда, 12 ноября**

8:30 – 9:00	Регистрация участников Школы		
9:00 – 9:15	<b>Открытие. Вступительное слово – член-корр. РАН Квон Зе Дон</b>		
9:15 – 10:00	<b>Квон Зе Дон</b>	ИФП СО РАН, г. Новосибирск	<i>Микроволновая и терагерцовская фотопроводимость: от квантовых точечных контактов к МОП-транзисторам</i>
10:00 – 10:45	<b>Зиновьев Айгуль Фанизовна</b>	ИФП СО РАН, г. Новосибирск	<i>Фаза Берри и топологические инварианты</i>
10:45 – 11:00	<b>Перерыв, кофе-брейк</b>		
11:00 – 11:45	<b>Ольшанецкий Евгений Борисович</b>	ИФП СО РАН, г. Новосибирск	<i>Двумерные топологические изоляторы</i>
11:45 – 12:30	<b>Ковалев Вадим Михайлович</b>	ИФП СО РАН, г. Новосибирск	<i>Рассеяние и сопротивление</i>
12:30 – 13:15	<b>Храпай Вадим Сергеевич</b>	ИФТТ РАН, г. Черноголовка	<i>Что такое кондактанс?</i>
13:15 – 14:15	<b>Обед</b>		
14:15 – 17:30	Представление стендов (презентация) участниками Школы		
	<b>Перерыв, кофе-брейк</b>		
	Стендовая сессия		

**Четверг, 13 ноября**

9:00 – 9:45	<b>Бетеров Илья Игоревич</b>	ИФП СО РАН, г. Новосибирск	<i>Ультрахолодные атомы</i>
9:45 – 10:30	<b>Голяшов Владимир Андреевич</b>	ИФП СО РАН, г. Новосибирск	<i>Исследование электронной структуры поверхности твердых тел методом фотоэлектронной спектроскопии с разрешением по углу и спину</i>
10:30 – 11:15	<b>Исламов Дамир Ревенирович</b>	ИФП СО РАН, г. Новосибирск	<i>Что такое мемристор?</i>
11:15 – 11:30	<b>Перерыв, кофе-брейк</b>		
11:30 – 12:15	<b>Миронов Алексей Юрьевич</b>	ИФП СО РАН, г. Новосибирск	<i>Фазовые переходы сверхпроводник-металл, сверхпроводник-изолятор и сверхпроводник-сверхизолятор</i>
12:15 – 13:00	<b>Лахно Виктор Дмитриевич</b>	ИМПБ РАН, г. Пущино	<i>Квантовая биология и биоинформатика на основе ДНК</i>
13:00 – 14:00	<b>Обед</b>		
14:00 – 14:45	<b>Бисти Вероника Евгеньевна</b>	ИФТТ РАН, г. Черноголовка	<i>Магнитоэкситоны в двумерных электронных системах</i>
14:45 – 15:30	<b>Михайлов Николай Николаевич</b>	ИФП СО РАН, г. Новосибирск	<i>Выращивание гетеро- и наноструктур на основе HgTe</i>
15:30 – 16:15	<b>Гуляев Дмитрий Владимирович</b>	ИФП СО РАН, г. Новосибирск	<i>Модуляция света: физика работы и применение в электронике</i>
16:15 – 16:30	<b>Вручение дипломов. Закрытие Школы</b>		



Институт физики  
полупроводников  
им. А.В. Ржанова СО РАН



Российский  
научный  
фонд

**12 ноября, среда, 14:15 – 17:30,**

**Представление стендов (презентация) молодыми участниками, конференц-зал  
Стендовая сессия, холл перед конференц-залом**

№ стенда	ФИО участника	Организация	Название доклада
1	<b>Баженов Александр Олегович</b>	Новосибирский государственный университет, г. Новосибирск	<i>Магнетотранспортные свойства тонких пленок топологического изолятора <math>Bi_xSb_{2-x}Te_{3-y}Se_y</math>, управляемые затворным напряжением: эффект Холла и магнетосопротивление</i>
2	<b>Бетке Игорь Андреевич</b>	Новосибирский государственный университет, г. Новосибирск	<i>Оптимизация параметров парофазного осаждения для роста массивов углеродных нанотрубок с низкой концентрацией дефектов</i>
3	<b>Ворсин Олег Игоревич</b>	Томский государственный университет, г. Томск	<i>Изучение изменения сверхструктурь <math>2xN</math> при epitаксиальном синтезе Ge на Si(001)</i>
4	<b>Дмитриев Виктор Сергеевич</b>	Томский государственный университет, г. Томск	<i>Разработка симулятора квантового компьютера</i>
5	<b>Дураков Денис Евгеньевич</b>	Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, г. Новосибирск	<i>In situ отражательная электронная микроскопия графитизации поверхности подложки 6H-SiC(0001) при высокотемпературном отжиге</i>
6	<b>Залиялов Тимур Маратович</b>	Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, г. Новосибирск	<i>Модель сдвига коэрцитивного напряжения сегнетоэлектрической конденсаторной структуры со временем при хранении поляризованного состояния</i>
7	<b>Захарук Юлия Сергеевна</b>	Новосибирский государственный технический университет, г. Новосибирск	<i>Излучательная рекомбинация в GeSi структурках, сформированных из ионно-молекулярных пучков</i>
8	<b>Карнаухов Сергей Олегович</b>	Томский государственный университет, г. Томск	<i>Временная нестабильность фононного крыла фотолюминесценции <math>NV^-</math>-центров в алмазе</i>
9	<b>Кузнецова Лада Сергеевна</b>	Новосибирский государственный университет, г. Новосибирск	<i>Исследование оптических свойств пленок CdTe в области края фундаментального поглощения</i>

<b>№ стенда</b>	<b>ФИО участника</b>	<b>Организация</b>	<b>Название доклада</b>
10	<b>Курмачев Дмитрий Андреевич</b>	Новосибирский государственный университет, г. Новосибирск	<i>Влияние магнитного поля на аномальные флюктуации кондактанса в мезоскопическом проводнике на основе двумерного полуметалла</i>
11	<b>Махмудиан Мехрдад Махмудович</b>	Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, г. Новосибирск	<i>Теория одномерного вигнеровского упорядочения локализованных электронов в нитриде кремния</i>
12	<b>Никифоров Данил Фёдорович</b>	Новосибирский государственный университет, г. Новосибирск	<i>Диагностика слоёв графена на подложке 6H-SiC (0001) методами атомно-силовой микроскопии и комбинационного рассеяния света</i>
13	<b>Плотников Никита Владимирович</b>	Томский государственный университет, г. Томск	<i>Синтез двумерного германия на поверхности высокоориентированного пиролитического графита</i>
14	<b>Поросев Юрий Вячеславович</b>	Новосибирский государственный технический университет, г. Новосибирск	<i>Оптимизация дизайна электронно- лучевой литографии при создания управляющих затворов спинового полупроводникового кубита</i>
15	<b>Снегирев Андрей Вячеславович</b>	Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, г. Новосибирск	<i>Термодинамические свойства сверхпроводника с дальнодействующими примесями</i>
16	<b>Стуколов Илья Сергеевич</b>	Новосибирский государственный университет, г. Новосибирск	<i>Транспортные свойства сверхизолирующих наноструктур на основе сверхпроводящих пленок <math>NbTiN</math></i>
17	<b>Хаматдинов Эльдар Ульфатович</b>	Томский государственный университет, г. Томск	<i>Температурная зависимость фононных мод в тонких пленках топологических изоляторов <math>Bi_2Te_3</math> и <math>BSTS</math></i>